

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-332343
(43)Date of publication of application : 30.11.2000

(51)Int.Cl. H01S 5/042
H01L 21/52
H01L 33/00

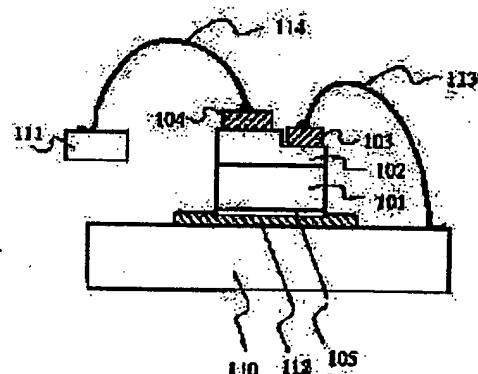
(21)Application number : 11-140946 (71)Applicant : SHARP CORP
(22)Date of filing : 21.05.1999 (72)Inventor : ITO SHIGETOSHI

(54) SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of manufacturing a semiconductor laser device having favorable productivity in a chip dividing process without deterioration of thermal resistance.

SOLUTION: This method of manufacturing a semiconductor laser device has steps of forming a multilayer metal film successively composed of a first metal film 105 and a second metal film 106, having a thickness through which a wafer surface structure can be confirmed from the backside of the wafer on the bottom surface of a wafer substrate for a semiconductor light emitting element provided with a transparent substrate 101 and a semiconductor laminate 102 provided thereon; performing alignment by recognizing the wafer surface structure from the wafer backside to form dividing grooves on the wafer backside and divide the wafer, thereby forming semiconductor light emitting element chips; loading a semiconductor light emitting element chips on a support substrate via solder with the substrate side down; and heating these so that the first metal film 105 is retained in a film and the second metal film 106 is melted into the solder.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-332343

(P2000-332343A)

(43)公開日 平成12年11月30日 (2000.11.30)

(51)Int.Cl'
H01S 5/042
H01L 21/52

識別記号

33/00

F I
H01S 3/18
H01L 21/52
33/00

6 2 4 5 F 0 4 1
D 5 F 0 4 7
B 5 F 0 7 3
E

マーク (参考)

審査請求 未請求 請求項の数17 OL (全 20 頁)

(21)出願番号 特願平11-140948

(22)出願日 平成11年5月21日 (1999.5.21)

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 伊藤 茂松

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内

(74)代理人 100103296

弁理士 小池 隆彌

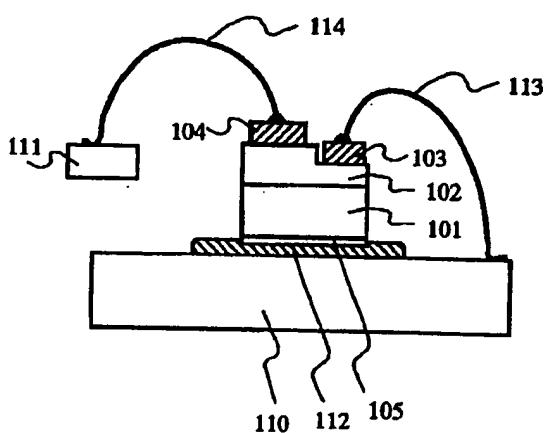
F ターム(参考) 5P041 AA33 AA41 CA04 CA05 CA34
CA46 CA82 CA85 CA86 CA87
CA92 CA98
5P047 AA18 BA06 BA17 CA08
5P073 AA13 AA45 AA74 CA17 CB05
CB22 CB23 DA30 DA34 FA14

(54)【発明の名称】 半導体発光装置およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 熱抵抗が劣化せず、しかも、チップ分割工程の生産性の良い半導体レーザ装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 半導体レーザ装置の製造方法において、透明な基板とその上に設けられた半導体積層体を備えた半導体発光素子ウェハーの基板下面に、ウェハー裏面側からウェハー表面の構造が透かして確認できる膜厚の、順次第1の金属膜と第2の金属膜とからなる多層金属膜を形成する工程と、ウェハー裏面側からウェハー表面の構造を認識してアライメントすることによりウェハー裏面に分割溝を形成してウェハーを分割し、半導体発光素子チップを得る工程と、前記半導体発光素子チップを基板側を下にし、ハンダを介して支持基体上に積載し、加熱することにより、前記第1の金属膜を膜状に残存させ、かつ、前記第2の金属膜はハンダに溶かし込む工程を有することにより、上記課題を解決する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明な基板と、その上に設けられた半導体積層体を備えた半導体発光素子チップと、支持基体とを備え、半導体発光素子チップが基板側を下にして支持基体にハンダにて固着されてなる半導体発光装置において、

半導体発光素子チップとハンダとの間には、膜厚が0.5 nm以上12 nm以下である、第1の金属膜が介装され、さらに、前記ハンダ中には、第2の金属とハンダとの混合物が形成されていることを特徴とする半導体発光装置。

【請求項2】 透明な基板と、その上に設けられた半導体積層体を備えた半導体発光素子チップと、支持基体とを備え、半導体発光素子チップが基板側を下にして支持基体にハンダにて固着されてなる半導体発光装置において、

半導体発光素子チップとハンダとの間には、第1の金属膜と、第2の金属膜とが介装され、第1の金属膜と第2の金属膜は透過部を有し、透過部は第1の金属膜の厚さが12 nm以下であり、第2の金属膜の膜厚が0であり、前記ハンダ中には、前記第2の金属とハンダとの混合物が形成されていることを特徴とする半導体発光装置。

【請求項3】 前記ハンダがInを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、かつ、前記第2の金属は、Ni、Ag、Au、Ga、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする、請求項1または2に記載の半導体発光装置。

【請求項4】 前記ハンダがPbを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Ni、Pd、Pt、Cu、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Ag、Au、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする、請求項1または2に記載の半導体発光装置。

【請求項5】 前記ハンダがSnを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Cu、Ag、Au、Zn、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする、請求項1または2に記載の半導体発光装置。

【請求項6】 前記ハンダがAuを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Ni、Pd、Ag、Au、Zn、Ga、In、Si、Ge、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする、請求項1または2に記載の半導体発光装置。

【請求項7】 透明な基板とその上に設けられた半導体積層体を備えた半導体発光素子ウェハーの基板下面に、ウェハー裏面側からウェハー表面の構造が確認できる透

過部を有する、第1の金属膜および第2の金属膜を含む多層膜を設ける工程と、ウェハー裏面側からウェハー表面の構造を認識してアライメントすることによりウェハー裏面に分割溝を形成してウェハーを分割し、半導体発光素子チップを得る工程を有することを特徴とする半導体発光装置の製造方法。

【請求項8】 前記透過部は、第1の金属膜と第2の金属膜がウェハー裏面からウェハー表面の構造を確認できる膜厚であることを特徴とする請求項7に記載の半導体発光装置の製造方法。

【請求項9】 前記透過部は前記半導体チップの全面に形成されていることを特徴とする請求項8に記載の半導体発光装置の製造方法。

【請求項10】 前記半導体発光素子チップを基板側を下にし、ハンダを介して支持基体上に積載し、加熱することにより、前記第1の金属膜を膜状に残存させ、かつ、前記第2の金属膜はハンダに溶かし込んで前記半導体発光素子チップを前記支持基体に固着させる工程と、を有することを特徴とする請求項7から9のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。

【請求項11】 前記透過部における第1の金属膜の膜厚が、0.5 nm以上12 nm以下であることを特徴とする、請求項8から10のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。

【請求項12】 前記透過部における第2の金属膜の膜厚が、3 nm以上25 nm以下であることを特徴とする、請求項8または10のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。

【請求項13】 前記透過部のチップ裏面に占める面積が20%以下であることを特徴とする請求項8に記載の半導体発光装置の製造方法。

【請求項14】 前記ハンダがInを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Ni、Ag、Au、Ga、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする、請求項7、8、9、10、11、12、13、14、15、16のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。

【請求項15】 前記ハンダがPbを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Ni、Pd、Pt、Cu、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Ag、Au、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする、請求項7、8、9、10、11、12、13、14、15、16のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。

【請求項16】 前記ハンダがSnを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、前記

3
第2の金属は、Cu、Ag、Au、Zn、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする、請求項7、8、9、10、11、12、13、14、15、16のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。

【請求項17】前記ハンダがAuを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Ni、Pd、Ag、Au、Zn、Ga、In、Si、Ge、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする、請求項7、8、9、10、11、12、13、14、15、16のいずれかに記載の半導体発光装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体発光装置の製造方法にかかわり、特に、半導体発光素子ウェハーの分割方法、あるいは、半導体発光素子チップの支持基体上へのダイボンド方法にかかわる。また、このような方法により製造された半導体発光装置の構造に係わる。

【0002】

【従来の技術】GaN、InN、AlNおよびそれらの混晶半導体に代表される窒化物系半導体からなる活性層を内包したレーザチップを備えた、半導体レーザ装置が試作されている。半導体レーザ装置においては、その動作時にレーザチップで発生する熱を効率良く支持基体に放散させて発光部の温度上昇にともなう特性劣化を抑制するために、レーザーチップが支持基体に熱伝導性良くマウントされる必要がある。図7は、このような技術に関する、特開平10-107384号公報に開示された半導体レーザ装置を示すものである。図において、71は酸化物基板、72は該基板表面上に形成された、窒化物系半導体の多層薄膜からなる半導体レーザ本体、73、74は半導体レーザ本体に電力を供給するための電極、75はヒートシンク（支持基体）、76は金属からなる導電性接着剤（ハンダ）であり、77は酸化物基板の裏面側表面に形成された金属膜である。金属膜77としては、酸化物に対して密着性の良い金属として知られている、Ti、Cr、W、Ni、Zr、Mo、Al、V等が選定され、その膜厚は0.1~0.2μmである。酸化物基板の裏面表面に、酸化物に対する密着性の良好な金属膜が形成されてなるから、半導体レーザチップとハンダとが強固に接着され、半導体レーザチップから支持基体への熱伝導性がよくなる。

【0003】このような、半導体レーザ装置は、以下に示す工程により製造できる。

【0004】始めに、サファイア等の酸化物基板71上（表面側）に、窒化物系半導体からなる多層薄膜72を結晶成長法により形成し、さらに、その上面に、電極73、74等を形成したウェハーを適宜作成する。その

後、ウェハーの裏面に上記金属膜77を蒸着法等により薄膜形成する。さらに、その後、基板裏面の所定の位置にダイヤモンドポイントで溝を入れ、この溝にしたがつて、ウェハーを分割することにより、個々のレーザチップを形成する。（スクライピング法）この際、半導体レーザの共振器ミラー一面も同時に形成することができる。さらにその後、レーザチップは、Au系ハンダ等のマウントに通常用いられているハンダにより、ステムもしくはサブマウントなどの支持基体上にダイボンドされ、半導体レーザ装置が完成する。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の技術においては、以下に示す問題がある。

【0006】上記半導体レーザ装置の製造工程において、酸化物基板上に窒化物系半導体が形成されたウェハーをレーザチップに分割する際、基板の裏面側にスクライプ溝を形成する必要がある。これは、エビ面側ではなく、基板側にスクライプ溝を形成した方が良好に分割できるためである。この際、スクライプ溝の位置は、ウェハーの表面側に形成されたレーザの構造（エッチング溝、電極パターン等）にアライメントされて、正確に形成されている必要がある。しかしながら、ウェハーの裏面には、金属膜77が積層されているために、ウェハーの裏面側から、表面のパターンを確認することができず、このままでは、溝の位置をアライメントすることが困難であった。よって、チップ分割工程に不便をきたし、レーザ装置等の生産性が良好でなかった。本発明は、チップ分割工程における上記問題を解消し、しかも、マウントされた半導体発光素子チップの熱抵抗を悪化させることのない、半導体レーザ装置の製造方法を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明の半導体発光装置にあっては、以下の構成により、上記問題点が解決される。

【0008】本発明の半導体発光装置は、透明な基板と、その上に設けられた半導体積層体を備えた半導体発光素子チップと、支持基体とを備え、半導体発光素子チップが基板側を下にして支持基体にハンダにて固定されてなる半導体発光装置において、半導体発光素子チップとハンダとの間には、膜厚が0.5nm以上12nm以下である、第1の金属膜が介装され、さらに、前記ハンダ中には、第2の金属とハンダとの混合物が形成されていることを特徴とする本発明の半導体発光装置は、透明な基板と、その上に設けられた半導体積層体を備えた半導体発光素子チップと、支持基体とを備え、半導体発光素子チップが基板側を下にして支持基体にハンダにて固定されてなる半導体発光装置において、半導体発光素子チップとハンダとの間には、第1の金属膜と、第2の金属膜とが介装され、第1の金属膜と第2の金属膜は透過

部を有し、透過部は第1の金属膜の厚さが12nm以下であり、第2の金属膜の膜厚が0であり、前記ハンダ中には、前記第2の金属とハンダとの混合物が形成されていることを特徴とする。

【0009】本発明の半導体発光装置は、前記ハンダがInを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、かつ、前記第2の金属は、Ni、Ag、Au、Ga、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする。

【0010】本発明の半導体発光装置は、前記ハンダがPbを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Ni、Pd、Pt、Cu、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Ag、Au、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする。

【0011】本発明の半導体発光装置は、前記ハンダがSnを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Cu、Ag、Au、Zn、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする。

【0012】本発明の半導体発光装置は、前記ハンダがAuを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Ni、Pd、Ag、Au、Zn、Ga、In、Si、Ge、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする。

【0013】本発明の半導体発光装置の製造方法は、透明な基板とその上に設けられた半導体積層体を備えた半導体発光素子ウェハーの基板下面に、ウェハー裏面側からウェハー表面の構造が確認できる透過部を有する、第1の金属膜および第2の金属膜を含む多層膜を設ける工程と、ウェハー裏面側からウェハー表面の構造を認識してアライメントすることによりウェハー裏面に分割溝を形成してウェハーを分割し、半導体発光素子チップを得る工程を有することを特徴とする。

【0014】本発明の半導体発光装置の製造方法は、前記透過部は、第1の金属膜と第2の金属膜がウェハー裏面からウェハー表面の構造を確認できる膜厚であることを特徴とする。

【0015】本発明の半導体発光装置の製造方法は、前記透過部は前記半導体チップの全面に形成されていることを特徴とする。

【0016】本発明の半導体発光装置の製造方法は、前記半導体発光素子チップを基板側を下にし、ハンダを介して支持基体上に積載し、加熱することにより、前記第1の金属膜を膜状に残存させ、かつ、前記第2の金属膜はハンダに溶かし込んで前記半導体発光素子チップを前記支持基体に固着させる工程と、を有することを特徴とす

する。

【0017】本発明の半導体発光装置の製造方法は、前記透過部における第1の金属膜の膜厚が、0.5nm以上12nm以下であることを特徴とする。

【0018】本発明の半導体発光装置の製造方法は、前記透過部における第2の金属膜の膜厚が、3nm以上25nm以下であることを特徴とする。

【0019】本発明の半導体発光装置の製造方法は、前記透過部のチップ裏面に占める面積が20%以下であることを特徴とする。

【0020】本発明の半導体発光装置の製造方法は、前記ハンダがInを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Ni、Ag、Au、Ga、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする。

【0021】本発明の半導体発光装置の製造方法は、前記ハンダがPbを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Ni、Pd、Pt、Cu、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Ag、Au、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする。

【0022】本発明の半導体発光装置の製造方法は、前記ハンダがSnを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Zn、Cd、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Cu、Ag、Au、Zn、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする。

【0023】本発明の半導体発光装置の製造方法は、前記ハンダがAuを主成分としてなり、前記第1の金属は、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Alのいずれかを含んでなり、前記第2の金属は、Ni、Pd、Ag、Au、Zn、Ga、In、Si、Ge、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んでなることを特徴とする。

【0024】なお、本明細書において、ハンダとは、電子デバイスの接合に用いられる溶融温度450℃以下の金属を表わしている。

【0025】

【発明の実施の形態】【実施の形態1】図1は、本発明の実施の形態1の半導体レーザ装置を示す模式図である。図において、101はサファイア基板であり、その上に窒化物系半導体の積層体102が形成されている。

また、窒化物系半導体の積層体102の表面には、n電極103、p電極104が設けられている。以上が、本実施の形態の半導体レーザ装置に用いられた半導体レーザチップの基本構成であり、その詳細については後述する。半導体レーザチップの裏面であるサファイア基板下面には、第1の金属膜105が設けられており、さらに、支持基体110上、前記第1の金属膜105との間にハンダ112が介在されることにより、半導体レーザ

チップが支持基体110の上に固定・積載されている。図示されないが、ハンド112中には、第2の金属膜材料とハンド材料との合金が一部形成されている。また、n電極103は、支持基体の一部とワイヤ113にて電気的に接続され、p電極104はピン111とワイヤ114にて電気的に接続されている。ここで、ピン111とは支持基体110とは絶縁された外部接続端子に電気的に接続されており、これにより、本実施の形態の半導体レーザ装置における半導体レーザチップに外部より電流が供給される。

【0026】図2は本実施の形態に用いた半導体レーザチップを端面から見た模式図である。本図は、レーザチップを図1の支持基体110にマウントする前の状況を示している。図において、窒化物系半導体の積層体102は、サファイア基板側から順に、AlGaNバッファ層201、n-AlGaNコンタクト層202、n-AlGaNクラッド層203、n-AlGaNガイド層204、AlGaN多重量子井戸活性層205、p-AlGaNガイド層206、p-AlGaNクラッド層207、p-AlGaNコンタクト層208が積層されて構成されている。pクラッド層207およびpコンタクト層208には、共振器方向に延伸したストライプ状のリッジ211が設けられ、また、p電極104と窒化物系半導体の積層体102との間には、リッジ部分を除いて、絶縁膜210が設けられている。このように、本実施の形態に用いた半導体レーザチップは、いわゆるリッジストライプ型構造を有している。また、窒化物系半導体の積層体102の一部に、表面より溝が設けられることによって、n電極103がn-AlGaNコンタクト層202に接続するように設けられている。さらには、レーザチップの裏面側には第1の金属膜105及び第2の金属膜106が形成されている。

【0027】以下に、図1および図2を参照しつつ本実施の形態の半導体レーザ装置の製造方法を説明する。

【0028】初めに、半導体素子の製造に用いられているプロセスを適宜適用して、サファイア基板101上に、図2に示したような個々の半導体レーザ構造が多数形成された半導体レーザウェハーを得た。このような、ウェハーを得る工程は、周知技術があるので、その詳細な記載は省略する。本実施の形態において、基板の厚みは350μmであり、窒化物系半導体の積層体102のトータルの厚みは約10μmであった。

【0029】次に、従来の技術にも記載したように、サファイア基板101の裏面側から、研磨もしくはエッチングにより、基板の一部を除去し、ウェハーの厚みを、通常40~120μm程度までに薄く調整する。これは、後の工程で、ウェハーを分割し個々のレーザチップに分割するのを容易にするための工程である。特に、レーザ端面ミラーも分割時に形成する場合には、35~8

0μmと、薄めに調整することが望ましい。本実施の形態においては、研削機を用いてウェハーの厚みを100μmに調整し、その後、研磨機を用いて50μmまで調整した。ウェハーの裏面は研磨機により磨かれているので平らであり、また、基板のサファイアが透明であることから、ウェハーの裏面側から、ウェハー表面に形成された構造（導波路構造、リッジ、電極パターン、絶縁膜パターン、エッチングパターン、溝等）が容易に観察できた。

10 【0030】次に、ウェハー裏面に第1の金属膜105、第2の金属膜106を順次形成した。ここで、第1の金属膜105は基板であるサファイアと密着性がよく、さらに、レーザチップをマウントする際にハンド112と混合しにくい金属を選定する必要があり、また、第2の金属膜106には、マウントの際に、上記ハンド112と混合しやすい金属を選定する必要がある。本実施の形態においては、第1の金属膜105には膜厚3nmのMoを、第2の金属膜106には膜厚10nmのAuを選定した。このような、薄い金属膜を膜厚の制御性20 良く形成するには、真空蒸着法が適しており、本実施の形態でもこの手法を用いたが、イオンプレーティング法やスパッタ法等の他の手法を用いても良いことは言うまでもない。ウェハー裏面に設けられたこれら2層の金属膜は、非常に薄いので、ウェハーの裏面側からウェハーを透かして表面に形成された構造を確認することができた。

【0031】その後、チップ分割工程により、ウェハーを個々の半導体レーザチップに分割した。この工程は、以下のように実施した。裏面側を上にしてステージ上に

30 上記得られたウェハーを置き、光学顕微鏡を用いウェハーを透かして表面構造を確認して、傷入れ位置をアライメントし、ウェハー裏面（サファイア基板）にダイヤモンドポイントでスクライブラインを入れた。傷入れ位置は、図2において記号220で示されているレーザチップの周囲に当る場所に相当する。それから、ウェハーに適宜力を加え、スクライブラインに沿ってウェハーを分割することで、図2に示されるような、個々のレーザチップを作製した。ここではスクライビング法によるチップ分割工程について説明したが、基板裏面側から傷、溝等を入れてチップを分割する方法であれば、同様にアライメントが可能であり、このような他の手法を用いても、同じ効果が得られることは言うまでもない。他の手法として、ワイヤソーもしくは薄板ブレードを用いて傷入れもしくは切断を行うダイシング法、エキシマレーザ等のレーザ光の照射加熱とその後の急冷により照射部にクラックを生じさせ、これをスクライブラインとするレーザスクライビング法、高エネルギー密度のレーザ光を照射し、この部分を蒸発させて溝入れ加工を行う、レーザブレーキング法等を用いても、同様にチップ分割工程が可能であった。

【0032】このように、本発明においては、透明な基板を用い、ウェハー裏面の金属膜を非常に薄く形成したので、チップ分割工程においてウェハー裏面から表面構造の確認が可能であった。

【0033】次に、ダイボンディング法により、レーザチップを支持基体上にマウントした。この工程は、以下のように実施した。まず、図1に示される支持基体110に、ハンダ112を塗布した。本実施の形態において、支持基体110はCuもしくはFeを主体とする金属からなり、その表面にNi膜/Au膜が順にメッキ形成されたものである。ハンダ112には、Inを用い、その塗布され後の厚みは1~20μm程度であった。ハンダはこのようにあらかじめ塗布により膜状に形成してもよいし、他の製膜方法例えれば、蒸着法、スパッタ法、印刷法、メッキ法等を用いてもよい。ただし、InもしくはSnを主成分とするハンダの場合のように、室温においてハンダが特に柔らかい場合には、生産性の極めて高い塗布法を用いることが好ましかった。また、次に、支持基体110を190℃程度のハンダの融点より若干高い温度まで加熱し、ハンダが溶けたところで、上記得られたレーザチップを裏面側を下にして載せ、さらに、荷重を適宜加えながら、温度を1分程度保持し、第2の金属膜106とハンダ112とをよく馴染ませた。これにより、第2の金属膜はハンダ中に溶解し、第2の金属膜材料とハンダ材料との合金が、図1に示されるハンダ112の一部に形成された。その後、支持基体を冷却し、ハンダが固化したところで本工程を終えた。尚、ここでは、本工程前にハンダを支持基体側に設けたが、逆にレーザチップ側に設けるようにしてもよい。

【0034】こうして、図1に示した本実施の形態の半導体レーザ装置が得られた。

【0035】上記工程によりマウントされたレーザチップを支持基体から強制的に引き剥がして、接着部分の状況を調べたところ、Auからなる第2の金属膜106は、ほとんどがハンダ112に溶け込んでしまって残っていない(チップ周辺部の一部に見られるハンダとのなじみが良好でない部分を除く。これは、チップ裏面が完全に平坦ではないために生じており、本発明の本質とは関係がない。)一方、Moからなる第1の金属膜105はそのままサファイア基板に接着して残っていた。つまり、本実施の形態の半導体レーザ装置においては、支持基体上に、ハンダ(ただし、第2の金属膜であるAuが一部に溶け込んでいる)および膜厚3nmのMoからなる第1の金属膜を介して半導体レーザチップがマウントされていた。また、選定した第1の金属膜は、基板との密着性が良好なものであった。このような状況にある、本実施の形態の半導体レーザ装置の熱抵抗を測定したところ、30K/Wであった。

【0036】この値を評価するために、Auからなる第2の金属膜の成膜時の厚さを0.5μmと変えた他は本

実施の形態と同様の方法で作製した対照半導体レーザ装置1を作製し、熱抵抗を測定したところ、28K/Wであった。また、このように金属膜を厚く形成したので、スクライプ工程時にウェハー裏面より表面構造を確認することは不可能であった。マウントされたレーザチップを支持基体から引き剥がして、接着部分の状況を調べたところ、Auからなる第2の金属膜は膜状に残存しており、その量はハンダと反応するに十分であることが確かめられた。一方、本実施の形態の半導体レーザ装置においては、第2の金属膜が極めて薄いにもかかわらず、熱抵抗の値としては、第2の金属膜を十分な厚さだけ付着した場合とほぼ同じであることが判明した。

【0037】Moからなる第1の金属膜の成膜時の厚さを0.1μmと変えた他は本実施の形態と同様の方法で作製した対照半導体レーザ装置2を作製し、熱抵抗を測定したところ、35K/Wであった。また、このように金属膜を厚く形成したので、スクライプ工程時にウェハー裏面より表面構造を確認することは不可能であった。また、マウント後も、Moからなる第1の金属膜が同じ厚さのまま残存していたことは、本実施の形態と同じであった。このように、第1の金属膜を厚く形成することで、本実施の形態と比較して、むしろ、わずかではあるが熱抵抗が上昇してしまうことが判明した。

【0038】第1の金属膜の材料をNiと変えたほかは本実施の形態と同様の方法で作製した対照半導体レーザ装置3を作製し、熱抵抗を測定したところ、60K/Wであった。なお前述のように、Niはサファイア等の酸化物基板に対して、密着性の良好な金属として知られているものである。このように金属膜を極めて薄く形成したので、スクライプ工程時にウェハー裏面より表面構造を確認することが可能であった。マウントされたレーザチップを支持基体から引き剥がして、接着部分の状況を調べたところ、第1の金属膜および第2の金属膜とも残存しておらず、また、引き剥がしに要する力は本実施の形態の場合と比較して極めて弱かった。これは、第1および第2の金属膜ともに膜を透かして反対側が目視できるほど薄く、また、第1の金属膜として、マウント時にハンダに溶け込んでしまう材料を選定したために、マウント工程中に第1および第2の金属膜ともハンダに溶け込んでしまい、マウント後の接着部分においてはハンダとサファイア基板とが直接接していることとなり、よって、支持基板とレーザチップとの接着強度が低下し、熱抵抗が増加したものと推察された。

【0039】第2の金属膜を省略したほかは、本実施の形態と同様の方法で作製した対照半導体レーザ装置4を作製したところ、マウント時に剥がれてしまう不良が多発した。これは、マウント時にハンダと反応する金属膜が省略されたために、良好なマウントが不可能となったことによると推察される。

【0040】以上の事実を整理すると次のようになる。

まず、第2の金属膜としては、接着性を良好なものとするために、マウント工程時にハンダと混じり合う金属を選定して設ける必要がある。これは、ウェハーの透明性を確保するために極めて薄く形成されることから、マウント工程を経ると、ハンダの中に溶け込んでなくなってしまう。また、第1の金属膜としては、ハンダに溶け込んでしまわない材料を選定する必要がある。これは、第1および第2の金属膜ともハンダに溶け込んでしまうと、最終的に、ハンダと透明基板とが直接接合されることになり、密着性が悪化して、熱抵抗が増大するからである。この点に着目して種々の金属材料を検討したところ、ハンダがInを主成分としてなるときには、第1の金属膜としてTi、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Zn、Cd、Alのいずれかを含んで構成したときに良好な結果が得られ、第2の金属膜としてNi、Ag、Au、Ga、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んで構成したときに良好な結果が得られた。さらに、ハンダがPbを主成分としてなるときには、第1の金属膜として、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Ni、Pd、Pt、Cu、Zn、Cd、Alのいずれかを含んで構成したときに良好な結果が得られ、第2の金属膜として、Ag、Au、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んで構成したときに良好な結果が得られたが、これについては、実施の形態3および4で再度説明する。ハンダがSnを主成分としてなるときには、第1の金属膜として、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Ni、Pd、Pt、Cd、Alのいずれかを含んで構成したときに良好な結果が得られ、第2の金属膜として、Cu、Ag、Au、Zn、In、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んで構成したときに良好な結果が得られたが、これについては、実施の形態6および7で再度説明する。ハンダがAuを主成分としてなるときには、第1の金属膜として、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Alのいずれかを含んで構成したときに良好な結果が得られ、第2の金属膜として、Ni、Pd、Ag、Au、Zn、Ga、In、Si、Ge、Sn、Pb、Sbのいずれかを含んで構成したときに良好な結果が得られたがこれについては、実施の形態8及び9で再度説明する。

【0041】さらに、第1の金属膜については、マウントされたレーザチップを支持基体から強制的に引き剥がして接着状況を検査した際に、基板側に膜状に残る程度に、基板に対する密着性の良好な金属を選定することが必要である。この点に注目して第1の金属膜材料を選定したところ、サファイア (α -Al₂O₃)、ルビー (α -Al₂O₃:Cr)、石英 (SiO₂)、MgAl₂O₄、MgGa₂O₄、NdGa₃O₃、LiGa₂O₂、LiAl₂O₂、ZnO、MgO等の酸化物基板に対しては、Ti、V、Zr、Ta、Cr、Mo、W、Fe、Co、Ni、Al、Si、Geのいずれかを含んで構成したときに良好な結果が得られ、GaN等の窒化物基板に対し

ては、Mg、Ti、Zr、Cr、Mo、W、Fe、Co、Ni、Pd、Ag、Zn、Al、Si、Geのいずれかを含んで構成した時に良好な結果が得られた。

【0042】次に、第1および第2の金属膜の膜厚について検討する。

【0043】第2の金属膜の厚さを本実施の形態の10nmに固定したまま、第1の金属膜の厚さを変えたところ、膜厚が7nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。第2の金属膜の厚さを後述の下限値(3nm)としたときには、膜厚が12nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。膜厚の下限については、あまりに薄い場合には、均一な薄膜形成が困難になるので、0.5nm以上が望ましかった。

【0044】逆に、第1の金属膜の厚さを本実施の形態の3nmに固定し、第2の金属膜の厚さを変えたところ、第2の金属膜には、比較的可視域での透過率の高い金属であるAuを用いているので、第1の金属膜と比較すると厚めでも許されるが、膜厚が16nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。第1の金属膜の厚さを前述の下限値(0.5nm)としたときには、膜厚が25nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。また、第2の金属膜としてAu以外の材料を選定したときには、上限値を15nmとすることが好ましかった。膜厚の下限については、マウント時にハンダと十分なじむだけの量が必要であって、マウント不良が増大しない限度から判断したところ、3nm程度であった。

【0045】さらに、膜厚を種々変更して生産性よく良好な分割、マウント条件が得られる範囲を検討したところ、第2の金属膜がAuである場合、1~4.5nmの範囲にある第1の金属膜に、膜厚5~15nmの範囲にある第2の金属膜を積層した構造とすることが望ましかった。第2の金属膜が上述のAu以外の材料である場合、1~4.5nmの範囲にある第1の金属膜に、膜厚3~10nmの範囲にある第2の金属膜を積層した構造とすることが望ましかった。

【0046】以上述べたように、本実施の形態によれば、それぞれ極めて薄い範囲に限定された膜厚を有し、上述の性質を持つてなる第1金属膜および第2金属膜をウェハー裏面に積層してからチップ分割したので、ウェハー裏面からウェハー上面にある構造を目視確認することができるという特徴を有する。これにより、チップ分割工程の再現性、制御性を高め、工程歩止りを従来の技術と比較して向上させることができた。またこのように、ウェハー裏面にアライメントのためのパターン形成を行なわなくても、ウェハー裏面側からウェハー表面の構造の目視確認が可能となった。本実施の形態のウェハーは窒化物半導体が、それと熱的性質の異なる酸化物基板上に形成され、しかも、その厚みが40~120μm

と、薄くなっているので、反りが生じやすいものである。このような場合、反っているウェハーの裏面チップ分割工程においてチップの位置を確認できないまま、単に一定間隔で溝入れを行うと、表面のパターンと溝入れ位置がずれてしまうことになるので、本実施の形態のチップ分割工程のように各チップのパターンが見える利点が非常に大きい。なお、このように薄くて反ったウェハーにフォトリソグラフィー法などのパターン形成法により、アライメントマークを設けるなどの手法は、ウェハーの割れを生じることがあって、生産性を低下させてしまう。本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、ウェハー裏面にこのようなパターン形成工程を施す必要がないので半導体発光装置の生産性が極めて高いものとなる。更に、上記説明に従って、第1金属膜及び第2金属膜を選定することにより、通常の厚い金属膜を設けた場合と比較して、熱抵抗はほとんど変わらないか、むしろ向上した。これにより、結果として、熱放散が良好であるために、高温特性および寿命特性の良好な半導体レーザ装置を生産性良く製造する事ができるようになった。

【実施の形態2】実施の形態1において、第1の金属膜(4.5nm)、第2の金属膜(4.5nm)を次の組み合わせとした他は、実施の形態1と同様の半導体レーザ装置を作製した。

【0047】(第1の金属膜、第2の金属膜) = (Ti, Ni)、(Ti, Ag)、(Ti, Au)、(Ti, Ga)、(Ti, In)、(Ti, Sn)、(Ti, Pb)、(Ti, Sb)、(Zr, Ni)、(Zr, Ag)、(Zr, Au)、(Zr, Ga)、(Zr, In)、(Zr, Sn)、(Zr, Pb)、(Zr, Sb)、(Cr, Ni)、(Cr, Ag)、(Cr, Au)、(Cr, Ga)、(Cr, In)、(Cr, Sn)、(Cr, Pb)、(Cr, Sb)、(Mo, Ni)、(Mo, Ag)、(Mo, Ga)、(Mo, In)、(Mo, Sn)、(Mo, Pb)、(Mo, Sb)、(W, Ni)、(W, Ag)、(W, Au)、(W, Ga)、(W, In)、(W, Sn)、(W, Pb)、(W, Sb)、(Fe, Ni)、(Fe, Ag)、(Fe, Au)、(Fe, Ga)、(Fe, In)、(Fe, Sn)、(Fe, Pb)、(Fe, Sb)、(Al, Ni)、(Al, Ag)、(Al, Au)、(Al, Ga)、(Al, In)、(Al, Sn)、(Al, Pb)、(Al, Sb)。

【0048】上記いずれの組み合わせにおいても、熱抵抗値29~35K/Wが得られ、良好な熱抵抗を初めとして、実施の形態1に記載されたのと同等の効果が確認された。

【0049】第2の金属膜の厚さを本実施の形態の4.5nmに固定したまま、第1の金属膜の厚さを変えたところ、膜厚が10nm程度になったときに、ウェハー裏

面からの表面構造の目視が不可能になった。第2の金属膜の厚さを後述の下限値(3nm)としたときには、膜厚が12nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。膜厚の下限については特に規定されないが、また、あまりに薄い場合には、均一な薄膜形成が困難になるので、0.5nm以上が望ましかった。逆に、第1の金属膜の厚さを本実施の形態の4.5nmに固定し、第2の金属膜の厚さを変えたところ、第2の金属膜には、比較的可視域での透過率の高い金属であるAuを用いた場合、膜厚が20nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。第1の金属膜の厚さを前述の下限値

(0.5nm)としたときには、膜厚が25nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。また、第2の金属膜としてAu以外の材料を選定したときには、上限値を15nmとすることが好ましかった。膜厚の下限については、マウント時にハングと十分なじむだけの量が必要であって。マウント不良が増大しない限度から判断したところ、3nm程度であった。

【0050】さらに、膜厚を種々変更して生産性よく良好な分割、マウント条件が得られる範囲を検討したところ、第2の金属膜がAuである場合、1~4.5nmの範囲にある第1の金属膜に、膜厚5~15nmの範囲にある第2の金属膜を積層した構造とすることが望ましかった。第2の金属膜が上述のAu以外の材料である場合、1~4.5nmの範囲にある第1の金属膜に、膜厚3~10nmの範囲にある第2の金属膜を積層した構造とすることが望ましかった。

【実施の形態3】実施の形態1において、基板をアンドープGaNとし、第1の金属膜、第2の金属膜を次の組み合わせとした他は、実施の形態1と同様の半導体レーザ装置を作製した。

【0051】以下に、実施の形態1における半導体レーザ装置の製造方法を参考にしつつ本実施の形態の半導体レーザ装置の製造方法を説明する。

【0052】初めに、半導体素子の製造に用いられているプロセスを適宜適用して、GaN基板上に、図2に示したのと同様の個々の半導体レーザ構造が多段形成された半導体レーザウェハーを得た。このような、ウェハーを得る工程は、周知技術であるので、その詳細な記載は省略する。本実施の形態において、基板の厚みは300μmであり、窒化物系半導体の積層体のトータルの厚みは約10μmであった。

【0053】次に、GaN基板の裏面側から、研磨もしくはエッチングにより、基板の一部を除去し、ウェハーの厚みを、通常60~200μm程度までに薄く調整する。これは、後の工程で、ウェハーを分割し個々のレーザチップに分割するのを容易にするための工程である。特に、レーザ端面ミラーも分割時に形成する場合には、

80~120 μm と、薄めに調整することが望ましい。本実施の形態においては、研磨機を用いてウェハーの厚みを100 μm に調整した。ウェハーの裏面は研磨機により磨かれているので平らであり、また、基板のGaNが透明であることから、ウェハーの裏面側から、ウェハー表面に形成された構造が容易に観察できた。

【0054】次に、ウェハー裏面に第1の金属膜、第2の金属膜を順次形成した。ここで、第1の金属膜は基板であるGaNと密着性がよく、さらに、レーザチップをマウントする際にハンダと混合しにくい金属を選定する必要があり、また、第2の金属膜には、マウントの際に、上記ハンダと混合しやすい金属を選定する必要がある。本実施の形態においては、第1の金属膜を膜厚3 nmとし、第2の金属膜を膜厚10 nmとした。このような、薄い金属膜を膜厚の制御性良く形成するには、真空蒸着法が適しており、本実施の形態でもこの手法を用いたが、イオンプレーティング法やスパッタ法等の他の手法を用いても良いことは言うまでもない。ウェハー裏面に設けられたこれら2層の金属膜は、非常に薄いので、ウェハーの裏面側からウェハーを透かして表面に形成された構造を確認することができた。

【0055】その後、チップ分割工程により、ウェハーを個々の半導体レーザチップに分割した。この工程は、以下のように実施した。裏面側を上にしてステージ上に上記得られたウェハーを置き、光学顕微鏡を用いてウェハーを透かして表面構造を確認して、傷入れ位置をアライメントし、ウェハー裏面(GaN基板)にダイヤモンドポイントでスクライプラインを入れた。傷入れ位置は、図2において記号220で示されているレーザチップの周囲に当る場所に相当する。それから、ウェハーに適宜力を加え、スクライプラインに沿ってウェハーを分割することで、個々のレーザチップを作製した。ここではスクライピング法によるチップ分割工程について説明したが、基板裏面側から傷、溝等を入れてチップを分割する方法であれば、同様にアライメントが可能であり、このような他の手法を用いても、同じ効果が得られるることは言うまでもない。他の手法として、ワイヤソーもしくは薄板ブレードを用いて傷入れもしくは切断を行うダイシング法、エキシマレーザ等のレーザ光の照射加熱とその後の急冷により照射部にクラックを生じさせ、これをスクライプラインとするレーザスクライピング法、高エネルギー密度のレーザ光を照射し、この部分を蒸発させて溝入れ加工を行う、レーザアブレーション法などを用いても、同様にチップ分割工程が可能であった。

【0056】このように、本発明においては、透明な基板を用い、ウェハー裏面の金属膜を非常に薄く形成したので、チップ分割工程においてウェハー裏面から表面構造の確認が可能であった。

【0057】次に、ダイボンディング法により、レーザチップを支持基体上にマウントした。この工程は、以下

のように実施した。まず、図1に示されるのと同様の支持基体に、ハンダを塗布した。本実施の形態において、支持基体はCuもしくはFeを主体とする金属からなり、その表面にNi膜/Au膜が順にメッキ形成されたものである。ハンダには、Inを用い、その塗布された厚みは1~20 μm 程度であった。ハンダはこのようにあらかじめ塗布により膜状に形成してもよいし、他の製膜方法例えば、蒸着法、スパッタ法、印刷法、メッキ法等を用いてもよい。ただし、InもしくはSnを主成分とするハンダの場合のように、ハンダが柔らかい場合には、生産性の極めて高い塗布法により設けることが好ましい。また、次に、支持基体を195°C程度のハンダの融点より若干高い温度まで加熱し、ハンダが溶けたところで、上記得られたレーザチップを裏面側を下にして戻せ、さらに、荷重を適宜加えながら、温度を1.5分程度保持し、第2の金属膜とハンダとをよく馴染ませた。その後、支持基体を冷却し、ハンダが固化したところで本工程を終えた。なお、ここでは、本工程前にハンダを支持基体側に設けたが、逆にレーザチップ側に設けるようにしてもよい。

【0058】こうして、図1に示したのと類似の本実施の形態の半導体レーザ装置が得られた。

【0059】上記工程によりマウントされたレーザチップを支持基体から強制的に引き剥がして、接着部分の状況を調べたところ、第2の金属膜は、ほとんどがハンダに溶け込んでしまって残っていない一方、第1の金属膜はそのままGaN基板に接着して残っていた。つまり、本実施の形態の半導体レーザ装置においては、支持基体上に、ハンダ(ただし、第2の金属膜が一部に溶け込んでいる)および膜厚3 nmの第1の金属膜を介して半導体レーザチップがマウントされていた。なお、本実施の形態における第1の金属膜、第2の金属膜は次の組み合わせより選定された。

【0060】(第1の金属膜、第2の金属膜) = (Ti, Ni)、(Ti, Ag)、(Ti, Au)、(Ti, Ga)、(Ti, In)、(Ti, Sn)、(Ti, Pb)、(Ti, Sb)、(Zr, Ni)、(Zr, Ag)、(Zr, Au)、(Zr, Ga)、(Zr, In)、(Zr, Sn)、(Zr, Pb)、(Zr, Sb)、(Cr, Ni)、(Cr, Ag)、(Cr, Au)、(Cr, Ga)、(Cr, In)、(Cr, Sn)、(Cr, Pb)、(Cr, Sb)、(Mo, Ni)、(Mo, Ag)、(Mo, Au)、(Mo, Ga)、(Mo, In)、(Mo, Sn)、(Mo, Pb)、(Mo, Sb)、(W, Ni)、(W, Ag)、(W, Au)、(W, Ga)、(W, In)、(W, Sn)、(W, Pb)、(W, Sb)、(Fe, Ni)、(Fe, Ag)、(Fe, Au)、(Fe, Ga)、(Fe, In)、(Fe, Sn)、(Fe, Pb)、(Fe, Sb)、(Zn, Ni)、(Zn, A)

g)、(Zn、Au)、(Zn、Ga)、(Zn、In)、(Zn、Sn)、(Zn、Pb)、(Zn、Sb)、(Cd、Ni)、(Cd、Ag)、(Cd、Au)、(Cd、Ga)、(Cd、In)、(Cd、Sn)、(Cd、Pb)、(Cd、Sb)、(Al、Ni)、(Al、Ag)、(Al、Au)、(Al、Ga)、(Al、In)、(Al、Sn)、(Al、Pb)、(Al、Sb)。

上記いずれの組み合わせにおいても、熱抵抗値20~28K/Wが得られ、実施の形態1よりも良好な熱抵抗値が確認された。これは、サファイアに比べて、GaNの熱伝導が良好なことによるものと思われる。その他の点についても、実施の形態1に記載したものと同等の効果が確認された。

【0061】次に、第1および第2の金属膜の膜厚について検討する。

【0062】第2の金属膜の厚さを本実施の形態の10nmに固定したまま、第1の金属膜の厚さを変えたところ、膜厚が7nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。第2の金属膜の厚さを後述の下限値(3nm)としたときには、膜厚が12nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。膜厚の下限については特に規定されないが、また、あまりに薄い場合には、均一な薄膜形成が困難になるので、0.5nm以上が望ましかった。

【0063】逆に、第1の金属膜の厚さを本実施の形態の3nmに固定し、第2の金属膜の厚さを変えたところ、第2の金属膜には、比較的可視域での透過率の高い金属であるAuを用いているので、第1の金属膜と比較すると厚めでも許されるが、膜厚が16nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。第1の金属膜の厚さを前述の下限値(0.5nm)としたときには、膜厚が25nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。また、第2の金属膜としてAu以外の材料を選定したときには、上限値を15nmとすることが好ましかった。膜厚の下限については、マウント時にハンダと十分なじむだけの量が必要であって、マウント不良が増大しない限度から判断したところ、3nm程度であった。

【0064】さらに、膜厚を種々変更して生産性よく良好な分割、マウント条件が得られる範囲を検討したところ、第2の金属膜がAuである場合、1~4.5nmの範囲にある第1の金属膜に、膜厚5~15nmの範囲にある第2の金属膜を積層した構造することが望ましかった。第2の金属膜が上述のAu以外の材料である場合、1~4.5nmの範囲にある第1の金属膜に、膜厚3~10nmの範囲にある第2の金属膜を積層した構造することが望ましかった。

【0065】以上、実施の形態1、2、3において、ハ

ンダをInとしたが、これは、合金組成としてInを最も多く含む他のハンダ材料でもよい。Inに、Ag、Sn、Pb、Al、Ge、Gaのいずれかが混合されたハンダ材料においても実施の形態1、2、3と同様の効果が得られた。

【実施の形態4】実施の形態1において、ハンダをPbSn(Sn 10wt%)とし、第1の金属膜、第2の金属膜を次の組み合わせとした他は、実施の形態1と同様にして半導体レーザ装置を作製した。ただし、マウント時の加熱温度は、ハンダの溶融温度にあわせて、330°Cに変更した。

【0066】(第1の金属膜、第2の金属膜) = (Ti、Ag)、(Ti、Au)、(Ti、In)、(Ti、Sn)、(Ti、Pb)、(Ti、Sb)、(Zr、Ag)、(Zr、Au)、(Zr、In)、(Zr、Sn)、(Zr、Pb)、(Zr、Sb)、(Cr、Ag)、(Cr、Au)、(Cr、In)、(Cr、Sn)、(Cr、Pb)、(Cr、Sb)、(Mo、Ag)、(Mo、Au)、(Mo、In)、(Mo、Sn)、(Mo、Pb)、(Mo、Sb)、(W、Ag)、(W、Au)、(W、In)、(W、Sn)、(W、Pb)、(W、Sb)、(Fe、Ag)、(Fe、Au)、(Fe、In)、(Fe、Sn)、(Fe、Pb)、(Fe、Sb)、(Ni、Ag)、(Ni、Au)、(Ni、In)、(Ni、Sn)、(Ni、Pb)、(Ni、Sb)、(PtSi、Ag)、(PtSi、Au)、(PtSi、In)、(PtSi、Sn)、(PtSi、Pb)、(PtSi、Sb)、(Al、Ag)、(Al、Au)、(Al、In)、(Al、Sn)、(Al、Pb)、(Al、Sb)。

【0067】上記いずれの組み合わせにおいても、熱抵抗値29~35K/Wが得られ、その他の点についても、実施の形態1に記載したものと同等の効果が確認された。さらに、各金属膜の膜厚については、実施の形態1に示したのと同じ範囲において、実施の形態1と同等の効果が得られた。

【実施の形態5】実施の形態3において、ハンダをPbSnAg(Sn 5wt%、Ag 2.5wt%)とし、第1の金属膜、第2の金属膜を次の組み合わせとした他は、実施の形態1と同様にして半導体レーザ装置を作製した。ただし、マウント時の加熱温度は、ハンダの溶融温度にあわせて、320°Cに変更した。

【0068】(第1の金属膜、第2の金属膜) = (Ti、Ag)、(Ti、Au)、(Ti、In)、(Ti、Sn)、(Ti、Pb)、(Ti、Sb)、(Zr、Ag)、(Zr、Au)、(Zr、In)、(Zr、Sn)、(Zr、Pb)、(Zr、Sb)、(Cr、Ag)、(Cr、Au)、(Cr、In)、(Cr、Sn)、(Cr、Pb)、(Cr、Sb)、(Mo、Ag)、(Mo、Au)、(Mo、In)、(Mo、Sn)、(Mo、Pb)、(Mo、Sb)。

o、Ag)、(Mo、Au)、(Mo、In)、(Mo、Sn)、(Mo、Pb)、(Mo、Sb)、(W、Ag)、(W、Au)、(W、In)、(W、Sn)、(W、Pb)、(W、Sb)、(Fe、Ag)、(Fe、Au)、(Fe、In)、(Fe、Sn)、(Fe、Pb)、(Fe、Sb)、(Ni、Ag)、(Ni、Au)、(Ni、In)、(Ni、Sn)、(Ni、Pb)、(Ni、Sb)、(Pd、Ag)、(Pd、Au)、(Pd、In)、(Pd、Sn)、(Pd、Pb)、(Pd、Sb)、(PtSi、Ag)、(PtSi、Au)、(PtSi、In)、(PtSi、Sn)、(PtSi、Pb)、(PtSi、Sb)、(Al、Ag)、(Al、Au)、(Al、In)、(Al、Sn)、(Al、Pb)、(Al、Sb)

上記いずれの組み合わせにおいても、熱抵抗値21~28K/Wが得られ、実施の形態4よりも良好な熱抵抗値が確認された。これは、サファイアに比べて、GaNの熱伝導が良好なことによるものと思われる。その他の点についても、実施の形態1に記載したものと同等の効果が確認された。さらに、各金属膜の膜厚については、実施の形態3に示したのと同じ範囲において、実施の形態3および1と同等の効果が得られた。

【0069】以上、実施の形態4、5において、ハンダをPbSn(Sn10wt%)もしくはPbSnAg(Sn5wt%、Ag2.5wt%)としたが、これは、合金組成としてPbを最も多く含む他のハンダ材料でもよい。Pbに、Ag、Sn、Sb、In、Ga、Zn、Geのいずれかが混合されたハンダ材料においても実施の形態4、5と同様の効果が得られた。

【実施の形態6】実施の形態1におけるハンダをSnとし、第1の金属膜、第2の金属膜を次の組み合わせとした他は、実施の形態1と同様の半導体レーザ装置を作製した。ただし、マウント時の加熱温度は、ハンダの溶融温度にあわせて、260°Cに変更した。

【0070】(第1の金属膜、第2の金属膜) = (Ti、Ag)、(Ti、Au)、(Ti、In)、(Ti、Sn)、(Ti、Pb)、(Ti、Sb)、(Zr、Ag)、(Zr、Au)、(Zr、In)、(Zr、Sn)、(Zr、Pb)、(Zr、Sb)、(Cr、Ag)、(Cr、Au)、(Cr、In)、(Cr、Sn)、(Cr、Pb)、(Cr、Sb)、(Mo、Ag)、(Mo、Au)、(Mo、In)、(Mo、Sn)、(Mo、Pb)、(Mo、Sb)、(W、Ag)、(W、Au)、(W、In)、(W、Sn)、(W、Pb)、(W、Sb)、(Ni、Ag)、(Ni、Au)、(Ni、In)、(Ni、Sn)、(Ni、Pb)、(Ni、Sb)、(Pd、Ag)、(Pd、Au)、(Pd、In)、(Pd、Sn)、(Pd、Pb)、(Pd、Sb)、(PtSi、Ag)、(PtSi、Au)、(PtSi、In)、(PtSi、Sn)、(PtSi、Pb)、(PtSi、Sb)、(Al、Ag)、(Al、Au)、(Al、In)、(Al、Sn)、(Al、Pb)、(Al、Sb)

i、Au)、(Ni、In)、(Ni、Sn)、(Ni、Pb)、(Ni、Sb)、(PtSi、Ag)、(PtSi、Au)、(PtSi、In)、(PtSi、Sn)、(PtSi、Pb)、(PtSi、Sb)、(Al、Ag)、(Al、Au)、(Al、In)、(Al、Sn)、(Al、Pb)、(Al、Sb)。

【0071】上記いずれの組み合わせにおいても、熱抵抗値29~35K/Wが得られ、実施の形態1と同等の効果が確認された。その他の点についても、実施の形態1に記載したものと同等の効果が確認された。さらに、各金属膜の膜厚については、実施の形態1に示したのと同じ範囲において、実施の形態1と同等の効果が得られた。

【実施の形態7】実施の形態3におけるハンダをSnAu(Au10wt%)とし、第1の金属膜、第2の金属膜を次の組み合わせとした他は、実施の形態1と同様の半導体レーザ装置を作製した。ただし、マウント時の加熱温度は、ハンダの溶融温度にあわせて、250°Cに変更した。

【0072】(第1の金属膜、第2の金属膜) = (Ti、Ag)、(Ti、Au)、(Ti、In)、(Ti、Sn)、(Ti、Pb)、(Ti、Sb)、(Zr、Ag)、(Zr、Au)、(Zr、In)、(Zr、Sn)、(Zr、Pb)、(Zr、Sb)、(Cr、Ag)、(Cr、Au)、(Cr、In)、(Cr、Sn)、(Cr、Pb)、(Cr、Sb)、(Mo、Ag)、(Mo、Au)、(Mo、In)、(Mo、Sn)、(Mo、Pb)、(Mo、Sb)、(W、Ag)、(W、Au)、(W、In)、(W、Sn)、(W、Pb)、(W、Sb)、(Ni、Ag)、(Ni、Au)、(Ni、In)、(Ni、Sn)、(Ni、Pb)、(Ni、Sb)、(Pd、Ag)、(Pd、Au)、(Pd、In)、(Pd、Sn)、(Pd、Pb)、(Pd、Sb)、(PtSi、Ag)、(PtSi、Au)、(PtSi、In)、(PtSi、Sn)、(PtSi、Pb)、(PtSi、Sb)、(Al、Ag)、(Al、Au)、(Al、In)、(Al、Sn)、(Al、Pb)、(Al、Sb)

b)。

【0073】上記いずれの組み合わせにおいても、熱抵抗値20~26K/Wが得られ、実施の形態6よりも良好な熱抵抗値が確認された。これは、サファイアに比べて、GaNの熱伝導が良好なことによるものと思われる。その他の点についても、実施の形態1に記載したものと同等の効果が確認された。さらに、各金属膜の膜厚については、実施の形態3に示したのと同じ範囲において、実施の形態3および1と同等の効果が得られた。

【0074】以上、実施の形態6、7において、ハンダをSnもしくはSnAu(Au10wt%)としたが、

これは、合金組成としてSnを最も多く含む他のハンダ材料でもよい。Snに、Ag、Pb、Sb、In、Zn、Cu、Auのいずれかが混合されたハンダ材料においても実施の形態6、7と同様の効果が得られた。

【実施の形態8】実施の形態1におけるハンダをAuSn (Sn 20 wt%) とし、第1の金属膜、第2の金属膜を次の組み合わせとした他は、実施の形態1と同様の半導体レーザ装置を作製した。ただし、マウント時の加熱温度は、ハンダの溶融温度にあわせて、330°Cに変更した。

【0075】(第1の金属膜、第2の金属膜) = (Ti, Ni)、(Ti, Pd)、(Ti, Ag)、(Ti, Au)、(Ti, Zn)、(Ti, Ga)、(Ti, In)、(Ti, AuSi)、(Ti, Sn)、(Ti, Pb)、(Ti, Sb)、(Zr, Ni)、(Zr, Pd)、(Zr, Ag)、(Zr, Au)、(Zr, Zn)、(Zr, Ga)、(Zr, In)、(Zr, AuSi)、(Zr, Sn)、(Zr, Pb)、(Zr, Sb)、(Cr, Ni)、(Cr, Pd)、(Cr, Ag)、(Cr, Au)、(Cr, Zn)、(Cr, Ga)、(Cr, In)、(Cr, AuSi)、(Cr, Sn)、(Cr, Pb)、(Cr, Sb)、(Mo, Ni)、(Mo, Pd)、(Mo, Ag)、(Mo, Au)、(Mo, Zn)、(Mo, Ga)、(Mo, In)、(Mo, AuSi)、(Mo, Sn)、(Mo, Pb)、(Mo, Sb)、(W, Ni)、(W, Pd)、(W, Ag)、(W, Au)、(W, Zn)、(W, Ga)、(W, In)、(W, AuSi)、(W, Sn)、(W, Pb)、(W, Sb)、(Fe, Ni)、(Fe, Pd)、(Fe, Ag)、(Fe, Au)、(Fe, Zn)、(Fe, Ga)、(Fe, In)、(Fe, AuSi)、(Fe, Sn)、(Fe, Pb)、(Fe, Sb)。

【0076】上記いずれの組み合わせにおいても、熱抵抗値28~34K/Wが得られ、実施の形態1と同等の効果が確認された。その他の点についても、実施の形態1に記載したものと同等の効果が確認された。さらに、各金属膜の膜厚については、実施の形態1に示したのと同じ範囲において、実施の形態1と同等の効果が得られた。

【実施の形態9】実施の形態3におけるハンダをAuSn (Sn 20 wt%) とし、第1の金属膜、第2の金属膜を次の組み合わせとした他は、実施の形態1と同様の半導体レーザ装置を作製した。ただし、マウント時の加熱温度は、ハンダの溶融温度にあわせて、330°Cに変更した。

【0077】(第1の金属膜、第2の金属膜) = (Ti, Ni)、(Ti, Pd)、(Ti, Ag)、(Ti, Au)、(Ti, Zn)、(Ti, Ga)、(Ti, In)、(Ti, AuSi)、(Ti, Sn)、

(Ti, Pb)、(Ti, Sb)、(Zr, Ni)、(Zr, Pd)、(Zr, Ag)、(Zr, Au)、(Zr, Zn)、(Zr, Ga)、(Zr, In)、(Zr, AuSi)、(Zr, Sn)、(Zr, Pb)、(Zr, Sb)、(Cr, Ni)、(Cr, Pd)、(Cr, Ag)、(Cr, Au)、(Cr, Zn)、(Cr, Ga)、(Cr, In)、(Cr, AuSi)、(Cr, Sn)、(Cr, Pb)、(Cr, Sb)、(Mo, Ni)、(Mo, Pd)、(Mo, Ag)、(Mo, Au)、(Mo, Zn)、(Mo, Ga)、(Mo, In)、(Mo, AuSi)、(Mo, Sn)、(Mo, Pb)、(Mo, Sb)、(W, Ni)、(W, Pd)、(W, Ag)、(W, Au)、(W, Zn)、(W, Ga)、(W, In)、(W, AuSi)、(W, Sn)、(W, Pb)、(W, Sb)、(Fe, Ni)、(Fe, Pd)、(Fe, Ag)、(Fe, Au)、(Fe, Zn)、(Fe, Ga)、(Fe, In)、(Fe, AuSi)、(Fe, Sn)、(Fe, Pb)、(Fe, Sb)。

【0078】上記いずれの組み合わせにおいても、熱抵抗値19~26K/Wが得られ、実施の形態8よりも良好な熱抵抗値が確認された。これは、サファイアに比べて、GaNの熱伝導が良好なことによるものと思われる。その他の点についても、実施の形態1に記載したものと同等の効果が確認された。さらに、各金属膜の膜厚については、実施の形態3に示したのと同じ範囲において、実施の形態3および1と同等の効果が得られた。

【0079】以上、実施の形態8、9において、ハンダをAuSn (Sn 20 wt%) としたが、これは、合金組成としてAuを最も多く含む他のハンダ材料でもよい。Auに、Ag、Sn、Sb、In、Ga、Ge、Siのいずれかが混合されたハンダ材料においても実施の形態8、9と同様の効果が得られた。

【0080】以上、実施の形態1ないし9において述べたように、本発明によれば、それぞれ極めて薄い範囲に限定された膜厚を有し、上述の性質を持ってなる第1金属膜および第2金属膜をウェハー裏面に積層してからマウントしたので、ウェハー裏面からウェハー上面にある構造を目視確認することができるという特徴を有する。

これにより、チップ分割工程の再現性、制御性を高め、工程歩止りを従来の技術と比較して向上させることができた。さらに、上記説明にしたがって、第1金属膜および第2金属膜を選定することにより、通常の厚い金属膜を設けた場合と比較して、熱抵抗はほとんど変わらないか、むしろ向上した。これにより、結果として、熱放散が良好であるために、高温特性および寿命特性の良好な半導体レーザ装置を、生産性良く製造することができるようになった。

【実施の形態10】図3は本発明の実施の形態10の半導体レーザ装置を示す模式図である。図において、実施

の形態1と同じ部分については同一の符号で表わした。101はサファイア基板であり、その上に窒化物系半導体の積層体102が形成されている。また、窒化物系半導体の積層体102の表面には、n電極103、p電極104が設けられている。以上が、本実施の形態の半導体レーザ装置に用いられた半導体レーザチップの基本構成であり、本実施の形態において、これを半導体レーザチップ本体300と呼ぶ。半導体レーザチップの裏面であるサファイア基板下面には、第1の金属膜305、第2の金属膜306が設けられており、さらに、これらと支持基体310との間にハンダ312が介在されることにより、半導体レーザチップが支持基体310の上に固定・積載されている。第2の金属膜306にはところどころに膜がなくなっているところがある。図示されないが、ハンダ312中には、第2の金属膜材料とハンダ材料との合金が一部形成されている。また、n電極103は、支持基体の一部とワイヤ313にて電気的に接続され、p電極104はピン311とワイヤ314にて電気的に接続されている。ここで、ピン311とは支持基体310とは絶縁された外部接続端子に電気的に接続されており、これにより、本実施の形態の半導体レーザ装置における半導体レーザチップに、外部より電流が供給されうる。

【0081】図4は本実施の形態に用いた半導体レーザチップを裏面斜め方向から見た斜視図である。本図は、レーザチップを支持基体310にマウントする前の状況を示している。図において、半導体レーザチップ本体300の裏面には、第1の金属膜および第2の金属膜306が形成されており、また、第2の金属膜306にはところどころに膜厚が極めて薄くなっている部分(透過部320)が設けられており、ここを通じて、チップ裏面側から表面の構造を目視することが可能になっている。透過部320は、周期150μm、透過部幅10μmの格子状に設けられており、チップ外形もしくは半導体レーザ導波構造から斜めに設けられている。

【0082】以下に、図3および図4を参照しつつ本実施の形態の半導体レーザ装置の製造方法を説明する。

【0083】初めに、半導体素子の製造に用いられているプロセスを適宜適用して、サファイア基板101上に、図2に示した個々の半導体レーザ構造が多段形成された半導体レーザウェーハーを得た。このような、ウェーハーを得る工程は、周知技術であるので、その詳細な記載は省略する。本実施の形態において、基板の厚みは420μmであり、窒化物系半導体の積層体102のトータルの厚みは約15μmであった。

【0084】次に、従来の技術にも記載したように、サファイア基板101の裏面側から、研磨もしくはエッチングにより、基板の一部を除去し、ウェーハーの厚みを、通常40~120μm程度までに薄く調整する。これは、後の工程で、ウェーハーを分割し個々のレーザチップ

に分割するのを容易にするための工程である。特に、レーザ端面ミラーも分割時に形成する場合には、35~80μmと、薄めに調整することが望ましい。本実施の形態においては、研削機を用いてウェーハーの厚みを120μmに調整し、その後、研磨機を用いて75μmまで調整した。ウェーハーの裏面は研磨機により磨かれているので平らであり、また、基板のサファイアが透明であることから、ウェーハーの裏面側から、ウェーハー表面に形成された構造が容易に観察できた。

10 【0085】次に、ウェーハー裏面に第1の金属膜305、第2の金属膜306を順次形成した。ここで、第1の金属膜305は基板であるサファイアと密着性がよく、さらに、レーザチップをマウントする際にハンダ312と混合しにくい金属を選定する必要があり、また、第2の金属膜306には、マウントの際に、上記ハンダ312と混合しやすい金属を選定する必要がある。本実施の形態においては、第1の金属膜305として膜厚3nmのMoを形成し、第2の金属膜の一部として膜厚3nmのAuを順次形成した。このような、薄い金属膜を膜厚の制御性良く形成するには、真空蒸着法が適しており、本実施の形態でもこの手法を用いたが、イオンプレーティング法やスパッタ法等の他の手法を用いても良いことは言うまでもない。さらに、フォトグラフィー法により、レジストパターンを設け、それから、スパッタ法により、膜厚200nmのAuをさらに成膜し、それから、フォトレジストと共に透過部320に形成されたAuを除去するようなリフトオフ法により、透過部を除いた部分に、第2の金属膜の一部としてさらに厚くAuをパターン形成した。なお、この工程はリフトオフ法に限らず、選択エッチング法や選択メッキ法のような半導体デバイスプロセスに用いられている他の公知のパターン成膜技術を用いても良い。透過部320において、ウェーハーの裏面側からウェーハーを透かして表面に形成された構造を確認する事ができた。

【0086】その後、チップ分割工程により、ウェーハーを個々の半導体レーザチップに分割した。この工程は、以下のように実施した。裏面側を上にしてステージ上に上記得られたウェーハーを置き、光学顕微鏡を用いウェーハーを透かして表面構造を確認して、傷入れ位置をアライメントし、ウェーハー裏面(サファイア基板)にダイヤモンドポイントでスライブラインを入れた。傷入れ位置は、図2において記号220で示されているレーザチップの周囲に当る場所に相当する。それから、ウェーハーに適宜力を加え、スライブラインに沿ってウェーハーを分割することで、図4に示されるような、個々のレーザチップを作製した。ここではスライビング法によるチップ分割工程について説明したが、基板裏面側から傷、溝等を入れてチップを分割する方法において、同様にアライメントが可能であり、このような他の手法を用いても、同じ効果が得られることは言うまでもない。他の手

*@として、ワイヤーもしくは薄板ブレードを用いて傷入れもしくは切断を行うダイシング法、エキシマレーザ等のレーザ光の照射加熱とその後の急冷により照射部にクラックを生じさせ、これをスクライブラインとするレーザスクライビング法、高エネルギー密度のレーザ光を照射し、この部分を蒸発させて溝入れ加工を行う、レーザアブレーション法等を用いても、同様にチップ分割工程が可能であった。

【0087】このように、本発明においては、透明な基板を用い、ウェハー裏面の金属膜を部分的に非常に薄く形成したので、チップ分割工程においてウェハー裏面から表面構造の確認が可能であった。

【0088】次に、ダイボンディング法により、レーザチップを支持基体上にマウントした。この工程は、以下のように実施した。まず、図3に示される支持基体301に、ハンダ312を塗布した。本実施の形態において、支持基体301はCuもしくはFeを主体とする金属からなり、その表面にNi膜/Au膜が順にメッキ形成されたものである。ハンダ312には、Inを用い、その塗布され後の厚みは1~20μm程度であった。ハンダはこのようにあらかじめ塗布により膜状に形成してもよいし、他の製膜方法例えは、蒸着法、スパッタ法、印刷法、メッキ法等を用いてもよい。ただし、InもしくはSnを主成分とするハンダの場合のように、室温において特に柔らかくハンダを用いた場合には、生産性の極めて高い塗布法により膜状の形成が可能であるので、本実施の形態のように支持基体301側にあらかじめ設けることが好ましい。また、次に、支持基体301を190°C程度のハンダの融点より若干高い温度まで加熱し、ハンダが溶けたところで、上記得られたレーザチップを裏面側を下にして載せ、さらに、荷重を適宜加えながら、温度を1分程度保持し、第2の金属膜306とハンダ312とを良好に馴染ませた。これにより、第2の金属膜の一部はハンダ中に溶解し、第2の金属膜材料とハンダ材料との合金が図3に示されるハンダ312の一部に形成された。その後、支持基体を冷却し、ハンダが固化したところで本工程を終えた。

【0089】こうして、図3に示した本実施の形態の半導体レーザ装置が得られた。

【0090】上記工程によりマウントされたレーザチップを支持基体から強制的に引き剥がして、接着部分の状況を調べたところ、実施の形態1の場合と異なってAuからなる第2の金属膜306は十分に厚いので、その一部がハンダ312に溶け込んでしまっているのみで、マウント工程後も膜状に残存していた。なお、引き剥がし後、Moからなる第1の金属膜305はそのままサファイア基板に接着して残っており、上記残存する第2の金属膜306はサファイア基板裏面側に被着した状態であった。つまり、本実施の形態の半導体レーザ装置においては、支持基体上に、ハンダ（ただし、第2の金属膜で

あるAuが一部に溶け込んでいる）および第1の金属膜、第2の金属膜を介して半導体レーザチップがマウントされていた。このような状況にある、本実施の形態の半導体レーザ装置の熱抵抗を測定したところ、30K/Wであった。

【0091】この値を評価するために、Auからなる第2の金属膜に透過部320を設けない他は本実施の形態と同様である実施の形態1のところに記載した対照レーザ装置1における熱抵抗28K/Wと比較すると、ほぼ同じであり、本実施の形態に示したように、チップ分割工程時にウェハー裏面より表面構造を確認するために透過部320を設けても、熱放散の程度はほぼ同じであることが判明した。

【0092】第2の金属膜を省略したほかは、本実施の形態と同様の方法で作製した対照半導体レーザ装置4においては、マウント時に剥がれてしまう不良が多発した。これは、マウント時にハンダと反応する金属膜が省略されたために、良好なマウントが不可能となったことによると推察される。

【0093】第1の金属膜の材料をNiと変えたほかは本実施の形態と同様の方法で作製した対照半導体レーザ装置5を作製し、熱抵抗を測定したところ、40K/Wとなり、悪化した。前述のように、Niはサファイア等の酸化物基板に対して、密着性の良好な金属として知られているものである。マウントされたレーザチップを支持基体から引き剥がして、接着部分の状況を調べたところ、チップの裏面には透過部を中心としてサファイアが露出している部分が見られ、この露出部分の面積は、マウント前に形成されていた透過部の面積より大きくなっていた。これは、第1の金属膜としてマウント時にハンダに溶け込んでしまう材料を選定したために、マウント工程中に透過部を起点として第1および第2の金属膜がハンダに溶け込んでしまい、接着性の極めて弱い接合であるハンダ-基板接合が、多くの領域で形成されてしまったため熱抵抗が悪化したものと考えられる。

【0094】以上の事実を整理すると次のようになる。まず、第2の金属膜としては、接着性を良好なものとするために、マウント工程時にハンダと混じり合う金属を選定して設ける必要がある。また、第1の金属膜としては、ハンダに溶け込んでしまわない材料を選定する必要がある。この点に着目すると、ハンダ、第1の金属膜、第2の金属膜の組み合わせとして、実施の形態1に記載したのと同じ組み合わせにおいて、それぞれ良好な結果が得られた。

【0095】さらに、第1の金属膜については、マウントされたレーザチップを支持基体から強制的に引き剥がして接着状況を検査した際に、基板側に膜状に残る程度に、基板に対する密着性の良好な金属を選定することが必要である。この点に着目すると、基板、第1の金属膜の組み合わせとして、実施の形態1に記載したのと同じ

組み合わせにおいて、それぞれ良好な結果が得られた。
【0096】次に、透過部における金属膜の膜厚について検討する。

【0097】透過部においても良好な接着が行われるよう、第1の金属膜および第2の金属膜の両方とも設け、これらの膜厚を設定すべき範囲は、実施の形態1に記載した範囲と同じである。すなわち、第2の金属膜の厚さを良好な接着が行われる場合の下限値(3 nm)としたときには、第1の金属膜の膜厚が12 nm程度になったときには、ウエハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。膜厚の下限については、あまりに薄い場合には、均一な薄膜形成が困難になるので、0.5 nm以上が望ましかった。第1の金属膜の厚さを前述の下限値(0.5 nm)としたときには、Auを用いた第2の金属膜の膜厚が25 nm程度になったときに、ウエハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。また、第2の金属膜としてAu以外の材料を選定したときには、上限値を15 nmとすることが好ましかった。膜厚の下限については、マウント時にハンダと十分なじむだけの量が必要であって、マウント不良が増大しない限度から判断したところ、3 nm程度であった。さらに、膜厚を種々変更して生産性よく良好な分割、マウント条件が得られる範囲を検討したところ、第2の金属膜がAuである場合、1~4.5 nmの範囲にある第1の金属膜に膜厚3~10 nmの範囲にある第2の金属膜を積層した構造とすることが望ましかった。以上が、透過部においても良好な接着が行われるように設定した透過部における第1及び第2の金属膜を膜厚の範囲である。

【0098】透過部の面積が相対的に小さい場合には、特に透過部においても接着が良好になるように積極的に考慮する必要はなく、金属膜が全く形成されなくともよい。ただし、チップ面積に対する透過部の面積比を20%以下、好ましくは10%以下に小さく設定する必要があった。

【0099】以上述べたように、本実施の形態によれば、ウエハー裏面にそれぞれ極めて薄い範囲に限定された膜厚を有し、上述の性質を持ってなる第1金属膜および第2金属膜が形成されている透過部を備えたので、チップ分割工程においてウエハー裏面からウエハー上面にある構造を目視確認することができるという特徴を有する。これにより、チップ分割工程の再現性、制御性を高め、工程歩止りを従来の技術と比較して向上させることができた。

【実施の形態11】実施の形態10において、基板、ハンダ、第1の金属、第2の金属の組み合わせを、実施の形態2ないし9に記載されたものに変えた他は、実施の形態10と同様の半導体レーザ装置を作製したところ、いずれの組み合わせにおいても、熱抵抗値19~32 K/Wが得られ、良好な熱抵抗値が確認された。その他の点についても、実施の形態1もしくは10に記載したも

のと同等の効果が確認された。さらに、透過部における各金属膜の膜厚については、実施の形態10に示したのと同じ範囲において、実施の形態10および1と同等の効果が得られた。

【実施の形態12】図5は本発明の実施の形態12の半導体レーザ装置を示す模式図である。図において、501はn-GaN基板であり、その上に窒化物系半導体の積層体502が形成されている。また、n-GaN基板501の裏面には、部分的にn電極503が、窒化物系半導体の積層体502の表面には、p電極504が設けられている。以上が、本実施の形態の半導体レーザ装置に用いられた半導体レーザチップの基本構成であり、その詳細については後述する。半導体レーザチップの裏面であるn-GaN基板下面には、第1の金属膜505が設けられており、さらに、支持基体510上、前記第1の金属膜505との間にハンダ512が介在されることにより、半導体レーザチップが支持基体510の上に固定・積載されている。図示されないが、ハンダ512中には、第2の金属膜材料とハンダ材料との合金が一部形成されている。また、p電極504はピン511とワイヤ514にて電気的に接続されている。ここで、ピン511とは支持基体510とは絶縁された外部接続端子に電気的に接続されており、これにより、本実施の形態の半導体レーザ装置における半導体レーザチップに、外部より電流が供給される。

【0100】図6は本実施の形態に用いた半導体レーザチップを端面から見た模式図である。本図は、レーザチップを支持基体510にマウントする前の状況を示している。図において、窒化物系半導体の積層体502は、n-GaN基板側から順に、n-GaNバッファ層601、n-AlGaN中間層602、n-AlGaN第2クラッド層603、n-AlGaNガイド層604、AlGaN多重量子井戸活性層605、p-AlGaNガイド層606、p-AlGaNクラッド層607、p-AlGaNコンタクト層608が積層されて構成されている。pクラッド層607およびpコンタクト層608には、共振器方向に延伸したストライプ状のリッジ611が設けられ、また、p電極604とpクラッド層607との間には、リッジ部分を除いて、n-AlGaNブロック層609、p-AlGaNキャップ層610が設けられている。このように、本実施の形態に用いた半導体レーザチップは、いわゆる埋め込みリッジストライプ型構造を有している。さらには、レーザチップの裏面側には、第1の金属膜505および第2の金属膜506が形成されている。

【0101】以下に、図5および図6を参照しつつ本実施の形態の半導体レーザ装置の製造方法を説明する。

【0102】初めに、半導体素子の製造に用いられるプロセスを適宜適用して、n-GaN基板501上

に、図6に示した個々の半導体レーザ構造が、多数形成された半導体レーザウェハーを得た。ウェハーの厚みは400μmであり、窒化物系半導体の積層体502のトータルの厚みは約5μmであった。

【0103】次に、n-GaN基板501の裏面側から、研磨もしくはエッティングにより、基板の一部を除去し、ウェハーの厚みを、通常60～200μm程度までに薄く調整する。これは、後の工程で、ウェハーを分割し個々のレーザチップに分割するのを容易にするための工程である。特に、レーザ端面ミラーも分割時に形成する場合には、80～120μmと、薄めに調整することが望ましい。本実施の形態においては、研削機を用いてウェハーの厚みを180μmに調整し、その後、研磨機を用いて110μmまで調整した。ウェハーの裏面は研磨機により磨かれているので平らであり、また、基板のn-GaNが透明であることから、ウェハーの裏面側から、ウェハー表面に形成された構造（導波路、リッジ、絶縁膜パターン、電極パターン、エッティングパターン、溝等）が容易に観察できたそれから、n-GaN基板の裏面にリフトオフ法により、パターン化されたn電極503を形成した。n電極503はn-GaN側から順に、Ti(30nm)/Al(100nm)/Mo(50nm)/Au(100nm)で構成される。n電極を可視光が透過しうるほど薄く形成すると、n-GaNとの電極特性（オーミックコンタクト性とその安定性）が悪化するため、これは、上記のように、十分に厚く形成した。また、パターンは、電極幅20μm、ピッチ100μmの正方格子状とした。

【0104】次に、ウェハー裏面全面に第1の金属膜505、第2の金属膜506を順次形成した。ここで、第1の金属膜505は基板であるn-GaNと密着性がよく、さらに、レーザチップをマウントする際にハンダ512と混合しにくい金属を選定する必要があり、また、第2の金属膜506には、マウントの際に、上記ハンダ512と混合しやすい金属を選定する必要がある。本実施の形態においては、第1の金属膜505には膜厚4nmのMoを、第2の金属膜506には膜厚8nmのAuを選定した。このような、薄い金属膜を膜厚の制御性良く形成するには、真空蒸着法が適しており、本実施の形態でもこの手法を用いたが、イオンプレーティング法やスパッタ法等の他の手法を用いても良いことは言うまでもない。ウェハー裏面に設けられたこれら2層の金属膜は、非常に薄いので、n電極の部分を除いた透過部620、ウェハーの裏面側からウェハーを透かして表面に形成された構造を確認することができた。

【0105】その後、チップ分割工程により、ウェハーを個々の半導体レーザチップに分割した。この工程は、以下のように実施した。裏面側を上にしてステージ上に上記得られたウェハーを置き、光学顕微鏡を用いウェハーを透かして表面構造を確認して、傷入れ位置をアライ

メントし、ウェハー裏面(n-GaN基板)にダイヤモンドポイントでスクライブラインを入れた。傷入れ位置は、図6において記号630で示されているレーザチップの周囲に当る場所に相当する。それから、ウェハーに適宜力を加え、スクライブラインに沿ってウェハーを分割することで、図6に示されるような、個々のレーザチップを作製した。ここではスクライビング法によるチップ分割工程について説明したが、基板裏面側から傷、溝等を入れてチップを分割する方法であれば、同様にアライメントが可能であり、このような他の手法を用いても、同じ効果が得られることは言うまでもない。他の手法として、ワイヤソーもしくは薄板ブレードを用いて傷入れもしくは切断を行うダイシング法、エキシマレーザ等のレーザ光の照射加熱とその後の急冷により照射部にクラックを生じさせ、これをスクライブラインとするレーザスクライビング法、高エネルギー密度のレーザ光を照射し、この部分を蒸発させて溝入れ加工を行う、レーザアブレーション法等を用いても、同様に、チップ分割工程が可能であった。

【0106】このように、本発明においては、透明な基板を用い、ウェハー裏面のn電極以外の部分の金属膜を非常に薄く形成したので、チップ分割工程においてウェハー裏面から表面構造の確認が可能であった。

【0107】次に、ダイポンディング法により、レーザチップを支持基体上にマウントした。この工程は、以下のように実施した。まず、図5に示される支持基体501に、ハンダ512を塗布した。本実施の形態において、支持基体501はCuもしくはFeを主体とする金属からなり、その表面にNi膜/Au膜が順にメッキ形成されたものである。ハンダ512には、Inを用い、その塗布され後の厚みは1～20μm程度であった。ハンダはこのようにあらかじめ塗布により膜状に形成してもよいし、他の製膜方法例えば、蒸着法、スパッタ法、印刷法、メッキ法等を用いてもよい。ただし、InもしくはSnを主成分とするハンダの場合のように、室温においてハンダが特に柔らかい場合には、生産性の極めて高い塗布法をもちいることが好ましかった。また、次に、支持基体501を190℃程度のハンダの融点よりも若干高い温度まで加熱し、ハンダが溶けたところで、上記得られたレーザチップを裏面側を下にして載せ、さらに、荷重を適宜加えながら、温度を1分程度保持し、第2の金属膜506とハンダ512とをよく馴染ませた。これにより、第2の金属膜はハンダ中に溶解し、第2の金属膜材料とハンダ材料との合金が、図5に示されるハンダ512の一部に形成された。その後、支持基体を冷却し、ハンダが固化したところで本工程を終えた。

【0108】こうして、図5に示した本実施の形態の半導体レーザ装置が作製された。

【0109】上記工程によりマウントされたレーザチップを支持基体から強制的に引き剥がして、透過部620

における接着部分の状況を調べたところ、Auからなる第2の金属膜506は、ほとんどがハンダ512に溶け込んでしまって残っていない一方、Moからなる第1の金属膜505はそのままn-GaN基板に接着して残っていた。つまり、本実施の形態の半導体レーザ装置においては、支持基体上に、ハンダ（ただし、第2の金属膜であるAuが一部に溶け込んでいる）および膜厚3nmのMoからなる第1の金属膜を介して半導体レーザチップがマウントされていた。このような状況にある、本実施の形態の半導体レーザ装置の熱抵抗を測定したところ、25K/Wであり、本実施の形態によっても良好な熱放散が確認された。

【0110】次に、透過部における金属膜の膜厚について検討する。

【0111】透過部においても良好な接着が行われるよう、第1の金属膜および第2の金属膜の両方とも設け、これらの膜厚を設定すべき範囲は、実施の形態1に記載した範囲と同じである。すなわち、第2の金属膜の厚さを良好な接着が行われる場合の下限値（3nm）としたときには、第1の金属膜の膜厚が12nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。膜厚の下限については、あまりに薄い場合には、均一な薄膜形成が困難になるので、0.5nm以上が望ましかった。第1の金属膜の厚さを前述の下限値（0.5nm）としたときには、Auを用いた第2の金属膜の膜厚が25nm程度になったときに、ウェハー裏面からの表面構造の目視が不可能になった。また、第2の金属膜としてAu以外の材料を選定したときには、上限値を15nmとすることが好ましかった。膜厚の下限については、マウント時にハンダと十分なじむだけの量が必要であって、マウント不良が増大しない限度から判断したところ、3nm程度であった。さらに、膜厚を種々変更して生産性よく良好な分割、マウント条件が得られる範囲を検討したところ、第2の金属膜がAuである場合、1~4.5nmの範囲にある第1の金属膜に、膜厚3~10nmの範囲にある第2の金属膜を積層下構造とする事が望ましかった。以上が透過部においても良好な接着が行われるように設定した透過部における第1および第2の金属膜の膜厚の範囲である。

【0112】透過部の面積が相対的に小さい場合には、特に透過部においても接着が良好になるように積極的に考慮する必要はなく、金属膜が全く形成されなくともよい。ただし、チップ面積に対する透過部の面積比を20%以下、好ましくは10%以下に小さく設定する必要があった。

【0113】以上述べたように、本実施の形態によれば、ウェハー裏面にそれぞれ極めて薄い範囲に限定された膜厚を有し、上述の性質を持ってなる第1金属膜および第2金属膜が形成されている透過部をn電極の他に備えたので、チップ分割工程においてウェハー裏面からウ

エハー上面にある構造を目視確認することができるという特徴を有する。これにより、チップ分割工程の再現性、制御性を高め、工程歩止りを従来の技術と比較して向上させることができた。

【実施の形態13】実施の形態12において、基板、ハンダ、第1の金属、第2の金属の組み合わせを、実施の形態2ないし9に記載されたものに変えた他は、実施の形態12と同様の半導体レーザ装置を作製したところ、いずれの組み合わせにおいても、熱抵抗値19~29K/Wが得られ、良好な熱抵抗値が確認された。その他の点についても、実施の形態1もしくは12に記載したものと同等の効果が確認された。さらに、各金属膜の膜厚については、実施の形態12に示したのと同じ範囲において、実施の形態12および1と同等の効果が得られた。

【0114】実施の形態10ないし13において、半導体発光素子チップもしくはウェハー裏面に設けられた透過部/透過部以外の領域の模様を、特定の例について説明したが、本発明の趣旨に基づけば、これは、上記特定の例にのみ限られるわけではない。例えば、格子（スカラ状）模様、正方格子、三方格子、ハチノス状、水玉状、その他不定形状等、種々の変更が可能である。

【0115】以上、いくつかの実施の形態においては、基板を特定の酸化物基板とした場合についてのみ詳細に説明したが、ルピー（ α -Al₂O₃ : Cr₂O₃）、石英（SiO₂）、MgAl₂O₄、MgGa₂O₄、NdGaO₃、LiGaO₂、LiAlO₂、ZnO、MgO等、他の可視光を透過しうる結晶成長用酸化物基板に適用しても良く、この場合でも各実施の形態と同様の効果が得られた。また、いくつかの実施の形態において、基板を特定の窒化物とした場合についてのみ詳細に説明したが、Al₁G_xN、AlN等、他の可視光を透過しうる結晶成長用窒化物基板に適用しても良く、この場合でも各実施の形態と同様の効果が得られた。さらには、本発明の趣旨に基づいて、酸化物、窒化物以外の他の可視光を透過しうる結晶成長用基板、例えば、SiCにも適用が可能であった。

【0116】さらに、本発明が適用される半導体レーザチップにおける光導波路構造は、上述の例に限られるものではない。セルフ・アラインド・ストラクチャ（SAS）構造、リッジ構造を始めとして、電極ストライプ構造、埋め込みヘテロ（BH）構造、チャネルド・サブストレイト・プレイナ（CSP）構造等の他のものとしても、本発明の本質にかかわるものではなく、上述と同様の効果が得られるのは当然である。また、各半導体層は、上述の材料に限定されるわけではなく、Al_xIn_yGa_{1-x-y}N（0≤x, y≤1）の他、他の半導体レーザ装置に用いられるIII-V族化合物半導体、II-VI族化合物半導体としても良いことも明らかである。

【0117】以上、発明の実施の形態では、本発明の半

導体発光装置として、半導体レーザ装置の例について説明したが、本発明の趣旨から明らかなように、これは、半導体発光ダイオード装置への適用も可能である。特に、高温動作（例えば60°Cの空気中で使用される）や、高出力動作（例えば60mA以上で駆動される）を使用目的とした半導体発光ダイオード装置のように、良好な放熱が必要とされる半導体発光ダイオード装置に適用すると効果的である。

【0118】

【発明の効果】本発明によれば、上記構成により、熱抵抗が劣化せず、しかも、チップ分割工程の生産性の良い半導体レーザ装置の製造方法を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1の半導体レーザ装置を示す図である。

【図2】本発明の実施の形態1の半導体レーザ装置におけるレーザチップを示す図である。

【図3】本発明の実施の形態10の半導体レーザ装置を示す図である。

【図4】本発明の実施の形態10の半導体レーザ装置におけるレーザチップを示す斜視図である。

【図5】本発明の実施の形態12の半導体レーザ装置を示す図である。

【図6】本発明の実施の形態12の半導体レーザ装置におけるレーザチップを示す図である。

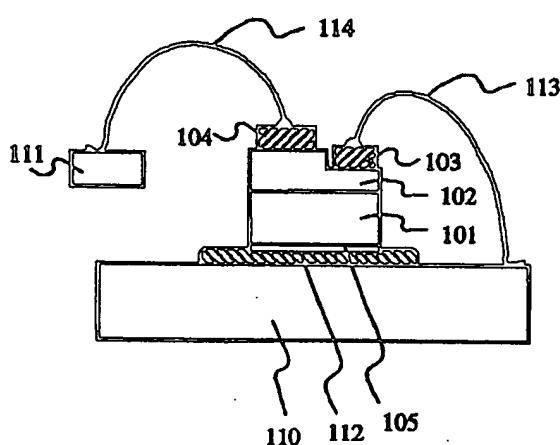
【図7】従来の技術に基づいた半導体レーザ装置を示す図である。

【符号の説明】

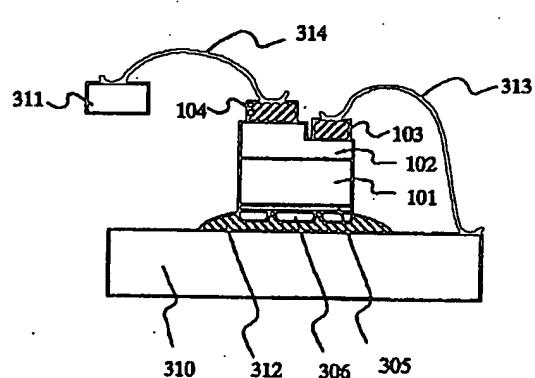
101 サファイア基板

102	窒化物系半導体の積層体
103	n電極
104	p電極
105	第1の金属膜
106	第2の金属膜
110	支持基体
111	ピン
112	ハンダ
113	ワイヤ
114	ワイヤ
305	第1の金属膜
306	第2の金属膜
310	支持基体
311	ピン
312	ハンダ
313	ワイヤ
314	ワイヤ
320	透過部
501	n-GaN基板
502	窒化物系半導体の積層体
503	n電極
504	p電極
505	第1の金属膜
506	第2の金属膜
510	支持基体
511	ピン
512	ハンダ
514	ワイヤ
620	透過部

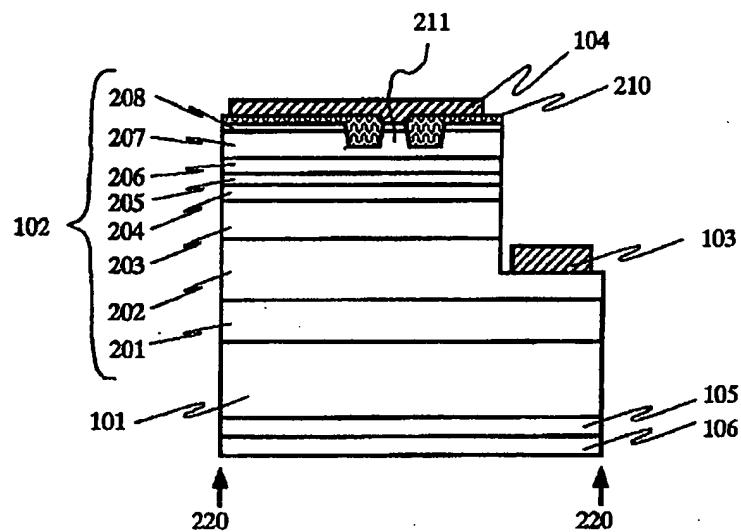
【図1】



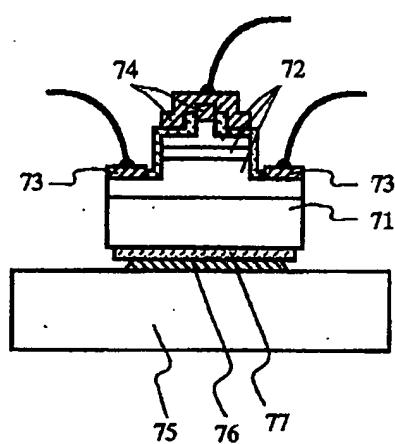
【図3】



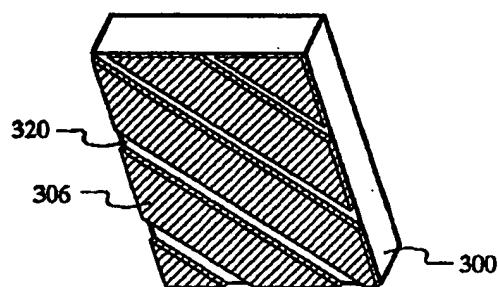
【図2】



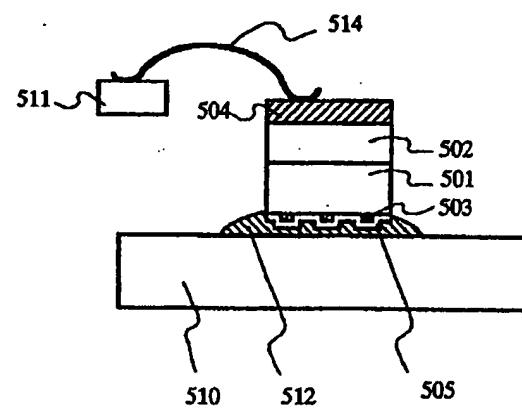
【図7】



【図4】



【図5】



【図6】

